

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 197 17 527 A 1**

⑤ Int. Cl.⁶
H 01 L 23/62
H 03 K 17/082
H 02 H 7/00
// H 01 F 7/18

⑳ Aktenzeichen: 197 17 527.9
㉑ Anmeldetag: 25. 4. 97
㉒ Offenlegungstag: 29. 10. 98

DE 197 17 527 A 1

㉓ Anmelder:
Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE

㉔ Erfinder:
Oettinger, Rolf, 71665 Vaihingen, DE; Andree,
Reinhold, 71735 Eberdingen, DE

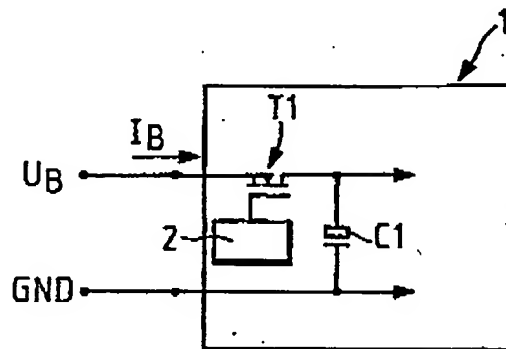
㉕ Entgegenhaltungen:
DE-Z: "Low-drop-Verpolschutz" - in:
Elektor 7-8/94, S. 122-123;

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

㉖ Elektronische Schaltung mit Verpolschutz

㉗ Es wird eine elektronische Schaltung mit einem Verpolschutz vorgeschlagen, bei der zwischen einer Versorgungsspannungsquelle und der elektronischen Schaltung ein N-Kanal-MOS-Feldeffekttransistor (T1) geschaltet ist, bei dem die Source-Drain-Strecke in Reihe zwischen einem Ausgang der Versorgungsspannungsquelle und einem Eingang der elektronischen Schaltung liegt und das Gate (G), vorzugsweise mittels eines internen Schaltreglers (3), derart ansteuerbar ist, daß bei einer Verpolung der Versorgungsspannung (U_B) ein Sperren der Source-Drain-Strecke erfolgt. Bei richtiger Polung der Versorgungsspannung (U_B) hat der MOS-Feldeffekttransistor (T1) eine geringe Verlustleistung.



DE 197 17 527 A 1

DE 197 17 527 A 1

Beschreibung

Stand der Technik

Die Erfindung betrifft eine elektronische Schaltung mit einem Schutz vor Beeinträchtigungen der Schaltung bei einer Verpolung der Versorgungsspannung nach dem Oberbegriff des Hauptanspruchs.

Es ist beispielsweise aus der Firmendruckschrift "Voltage Regulator Handbook 1982", Seiten 7 bis 39, der Firma National Semiconductor Corporation bekannt, zwischen der Versorgungsspannung und einer elektronischen Schaltung eine Schutzschaltung aus Halbleiterdioden vorzusehen. Diese Halbleiterdiode kann beispielsweise am Eingang der Schaltung in Reihe geschaltet werden, so daß der Eingangsstrom I_b nur in der Durchlaßrichtung der Halbleiterdiode fließen kann. Wird die Versorgungsspannung falsch gepolt, sperrt die Halbleiterdiode den Stromfluß.

In dieser bekannten Schutzschaltung können beispielsweise bei einer Anwendung für elektronische Schaltungen zur Ansteuerung von Leistungsbauelementen Ströme von 2,5 A bis 3 A fließen, wobei dann ein Spannungsabfall von ca. 0,7 V in der Durchlaßrichtung an der Halbleiterdiode eine Verlustleistung von ca. 2 W erzeugt. Diese relativ hohen Verlustleistungen verursachen bei empfindlichen elektronischen Schaltungen thermische Probleme.

Bei einer Variante der bekannten Schutzschaltung mit einer parallel zu den Polen der Versorgungsspannung geschalteten Halbleiterdiode ist es nachteilig, daß hier eine Sicherung (zum Beispiel eine Schmelzsicherung) in Reihe geschaltet werden muß, die bei einer falschen Polung, die die Halbleiterdiode in Durchlaßrichtung - quasi als Kurzschluß - betreibt, den Stromfluß unterbricht. Im Normalbetrieb mit richtiger Polung der Versorgungsspannung entsteht hier zwar keine Verlustleistung, jedoch muß nach einer falschen Polung der Versorgungsspannung die Sicherung ausgewechselt werden, was bei kompakten elektronischen Schaltungen sehr hinderlich ist.

Vorteile der Erfindung

Eine elektronische Schaltung der eingangs beschriebenen Art ist mit den erfindungsgemäßen Merkmalen des Kennzeichens des Hauptanspruchs dadurch vorteilhaft, daß durch den Einsatz eines MOS-Feldeffekttransistors ein Verpolenschutz erreicht wird, der im Normalfall der richtigen Polung und eines Stromflusses durch die Source-Drain-Strecke eine äußerst geringe Verlustleistung in der Größenordnung von 0,18 W aufweist.

Besonders kostengünstige und platzsparende MOS-Feldeffekttransistoren sind gemäß der bevorzugten Ausführungsform in N-Kanal-Technologie ausgeführt. Zum Durchsteuern der Source-Drain-Strecke des MOS-Feldeffekttransistors benötigt dieser eine Gate-Spannung, die größer ist als die Versorgungsspannung U_B , die am Source-Anschluß anliegt, da die Gate-Spannung positiv gegenüber der Source-Spannung sein muß. Die für sich bekannten Parameter von MOS-Feldeffekttransistoren sind beispielsweise in U. Tietze/Ch. Schenk, "Halbleiterschaltungstechnik", 5. Auflage 1980, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, Seiten 77 bis 88 beschrieben.

Die erfindungsgemäße Schaltung kann in vorteilhafter Weise zur Ansteuerung von elektromagnetischen Hydraulikventilen in mobilen oder in stationären Maschinen, wie zum Beispiel in Werkzeugmaschinen, pressen oder Spritzgießmaschinen dienen. Da zu Wartungs- oder Reparaturzwecken von Zeit zu Zeit Eingriffe in die Steuerungselektronik vorgenommen werden müssen, ist eine Vertauschung

2

der Polarität der Versorgungsspannung beim Anschluß der Schaltung an die Versorgungsspannung durch das Servicepersonal nicht immer auszuschließen. Um die hierdurch verursachte Fehlfunktion oder Zerstörung der Schaltung und eventuell auch der angeschlossenen Aggregate zu verhindern, ist ein Schutz der elektronischen Schaltung notwendig.

Bei der erfindungsgemäßen Ausführungsform mit einem N-Kanal-MOS-Feldeffekttransistor kann in besonders vorteilhafter Weise eine dynamische Ansteuerung des Gates dadurch bewerkstelligt werden, daß die positive Gate-Source-Spannung nicht über eine üblicherweise notwendige separate Spannungs-Pumpschaltung erzeugt wird, sondern aus der, vor Verpolung zu schützenden Schaltung selbst gewonnen wird.

Insbesondere beim Einsatz der elektronischen Schaltung zur Ansteuerung von Hydraulikventilen enthält die Schaltung zur Eigenversorgung interne Spannungsstabilisierungsschaltungen in getakterter Schaltreglerbauweise, die die benötigte Gate-Spannung auf einfache Weise erzeugen können.

Es ist mit der Erfindung auf jeden Fall ein Verpolenschutz erreicht, der nur äußerst geringe Verlustwärme erzeugt, was insbesondere bei weitgehend integrierten und gekapselten Schaltungsanordnungen zur Leistungssteuerung von elektromechanischen Bauteilen wichtig ist, da hier die Verlustwärme nur schwer wieder abgeführt werden kann.

Besonders vorteilhaft ist außerdem, daß die erfindungsgemäße Anordnung eines N-Kanal-MOS-Feldeffekttransistors auch einen bidirektionalen Stromfluß, bei entsprechender Ansteuerung des Gates, ermöglicht. Beispielsweise kann eine Rückspeisenergie beim Abschalten von Verbrauchern die Lastinduktivitäten aufweisen (z. B. Magnetventile) am Ausgang der elektronischen Schaltung zur Versorgungsspannungsquelle zurückgeleitet werden. Hiermit kann die relativ niedrige Quellimpedanz der Versorgungsspannungsquelle mit externen Stützkondensatoren vorteilhaft ausgenutzt werden und somit die Rückspeisenergie aufgefangen werden.

Vorteilhaft ist auch der erfindungsgemäße reverse Betrieb des MOS-Feldeffekttransistors, da hier die Gate-Source-Spannung nicht separat begrenzt werden muß. Aufgrund der Kombination des Verpolenschutzes mit dem internen Schaltregler kann die Gate-Source-Spannung nie größer als die stabilisierte Ausgangsspannung des Schaltreglers werden; somit wird auch keine überschüssige Energie in den Gatekreis des MOS-Feldeffekttransistors gefordert.

Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Zeichnung

Ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen elektronischen Schaltung mit einem Verpolenschutz wird anhand der Zeichnung erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Prinzipschaltbild einer elektronischen Schaltung mit einem MOS-Feldeffekttransistor als Verpolenschutz;

Fig. 2 zeigt ein detailliertes Ausführungsbeispiel der Anordnung nach Fig. 1 und

Fig. 3 Spannungsverläufe beim Betrieb der elektronischen Schaltung.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

In der Fig. 1 ist ein Prinzipschaltbild mit einer elektronischen Schaltung 1 gezeigt, die an einem Eingang mit einer Versorgungsspannung U_B beaufschlagt und mit einem anderen Eingang an Maße GND gelegt ist. In die Schaltung fließt eine Strom I_b die Schaltung kann ausgangseitig, wie in der

Beschreibungseinleitung erwähnt, beispielsweise zur Ansteuerung von elektromagnetischen Hydraulikventilen dienen.

Um im Falle einer Verpolung der Versorgungsspannung U_B die Schaltung 1 zu schützen ist ein N-Kanal-MOS-Feldeffekttransistor T1 mit seiner Source-Drain-Strecke in den Stromkreis geschaltet. Die Steuerung des Stromflusses, d. h. im Normalfall den möglichst widerstandslosen Durchlaß des Stromes I_B und im Fall einer Verpolung die Sperrung, erfolgt über eine entsprechende Gate-Spannung, die mittels einer Gate-Spannungserzeugungsschaltung 2 gewonnen wird. Ein Kondensator C1 dient der Glättung der Spannung U_B .

Fig. 2 zeigt ein detailliertes Schaltbild der elektronischen Schaltung 1. Der MOS-Feldeffekttransistor T1 weist hier zwischen seinem Source-Anschluß S und seinem Gate-Anschluß G noch eine Parallelschaltung aus einem Widerstand RG und einem Kondensator CG auf; der Drain-Anschluß D ist direkt an den Ausgang der elektronischen Schaltung 1 durchgeführt. Die Ansteuerung des Gates G erfolgt über einen Schaltregler 3, der zur Gewinnung einer stabilisierten Spannung U_{stab} in der elektronischen Schaltung schon zu anderen Zwecken vorhanden ist.

Der Schaltregler 3, dessen Funktion für sich gesehen auch aus dem in der Beschreibungseinleitung erwähnten Fachbuch "Halbleiterschaltungstechnik", Seiten 390 bis 395 bekannt ist, weist einen Schalttransistor T2, eine Schaltinduktivität LS, eine Diode DS und einen Glättungskondensator C2 auf.

Der Verpolschutz mit dem MOS-Feldeffekttransistor T1 wird mittels eines Transistors T3, Widerständen R1 und R2, Dioden D1 und D2 sowie eines Pumpkondensators CP realisiert. Der Transistor T3 liegt mit seinem Emitter an der Spannung U_{stab} und mit seinem Kollektor über die zwei in Reihe geschalteten Dioden D1 und D2 am Gate des MOS-Feldeffekttransistors T1. Die Basis des Transistors T3 liegt an einem Spannungsteiler aus den Widerständen R1 und R2 zwischen der Spannung U_{stab} und GND und der Pumpkondensator CP ist zwischen einem Anschlußpunkt zwischen den Dioden D1 und D2 und dem Kollektor des Transistors T2 geschaltet.

Im folgenden soll die Funktion, insbesondere im Hinblick auf den Schutz der Schaltung 1 vor einer Verpolung, unter Bezug auf die Spannungsdiagramme nach Fig. 3 erläutert werden. Nach einem Einschalten der Versorgungsspannung $+U_B$ mit der richtigen Polung hat der MOS-Feldeffekttransistor T1 noch keine Gate-Spannung, so daß er im Sperrzustand ist. Allerdings weist der MOS-Feldeffekttransistor T1 eine parasitäre Substratdiode auf (der Substratan Anschluß befindet sich im Transistorschaltzeichen zwischen dem Source- und dem Drain-Anschluß und ist in der Regel mit dem Source-Anschluß verbunden), die die Source-Drain-Strecke des MOS-Feldeffekttransistors T1 für den Fall, daß eine positive Spannung am Source-Anschluß liegt, leitend macht und somit wie eine bipolare Diode wirkt.

Sobald sich die Spannung U_B am Emitter des Transistors T2 aufgebaut hat beginnt der Schaltregler 3 zu arbeiten. Die Emitter-Basis-Spannung U_{eb} des Transistors T2 ist im Diagramm A der Fig. 3 dargestellt. Der Schalttransistor T2 wird hierbei im Takt eines sogenannten pulsbreitenmodulierten Signals PWM (pulse with modulated signal) in Abhängigkeit von der Abweichung der stabilisierten Spannung U_{stab} vom Sollwert so geöffnet, daß am Kollektor des Schalttransistors T2 ein entsprechendes Rechtecksignal nach dem Diagramm B der Fig. 3 ansteht.

Um die erforderliche größere Spannung (größer als $+U_B$) am Gate G des MOS-Feldeffekttransistors T1 zu gewinnen, die zu einer dauerhaften, nahezu widerstandslosen Durch-

schaltung der Source-Drain-Strecke führt, tritt die sog. Pumpschaltung in Aktion. Der Pumpkondensator CP wird nunmehr in der sog. Lowphase des Rechtecksignals nach dem Diagramm B zunächst auf die Spannung U_{stab} aufgeladen und in der anschließenden Highphase um die Spannung U_B zusätzlich angehoben (vgl. Diagramm C der Fig. 3), so daß eine Maximalspannung $U_B + U_{stab}$ entstehen kann. Es steht in diesem Betriebszustand somit immer eine Spannung von $+U_{stab}$ bezogen auf $+U_B$ am Gate des MOS-Feldeffekttransistors T1 an solange der Schaltregler 3 arbeitet.

Bei einer richtigen Polung der Versorgungsspannung U_B arbeitet der MOS-Feldeffekttransistor T1 also im sog. reversen Durchlaßbetrieb; im Fall einer falschen Polung der Versorgungsspannung U_B bleibt der MOS-Feldeffekttransistor T1 gesperrt, da hier der interne Schaltregler 3 überhaupt nicht zu arbeiten beginnt und keine Gate-Spannung erzeugt wird.

Patentansprüche

1. Elektronische Schaltung mit einem Verpolschutz, - bei der zwischen einer Versorgungsspannungsquelle und der elektronischen Schaltung ein Halbleiterbauelement geschaltet ist, dadurch gekennzeichnet, daß
 - das Halbleiterbauelement ein MOS-Feldeffekttransistor (T1) ist, bei dem die Source-Drain-Strecke in Reihe zwischen einem Ausgang der Versorgungsspannungsquelle und einem Eingang der elektronischen Schaltung geschaltet ist und das Gate (G) derart ansteuerbar ist, daß bei einer Verpolung der Versorgungsspannung (U_B) ein Sperren der Source-Drain-Strecke bewirkt wird.
2. Elektronische Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
 - der MOS-Feldeffekttransistor (T1) in N-Kanal-Technologie ausgeführt ist und eine Steuerspannung für das Gate (G) des MOS-Feldeffekttransistors (T1) mittels einer Gate-Spannungserzeugungsschaltung (2) erzeugbar ist.
3. Elektronische Schaltung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß
 - Bestandteil der elektronischen Schaltung (1) ein Schaltregler (3) ist, der für den Einsatz der Schaltung (1) unabhängig vom Verpolschutz vorgesehen ist, wobei mit dem Schaltregler (3) Spannungen erzeugbar sind aus der die, gegenüber der Versorgungsspannung (U_B), größere Gate-Spannung herleitbar ist.
4. Elektronische Schaltung Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß
 - die Gate-Spannung des MOS-Feldeffekttransistors (T1) aus der Ausgangsspannung (U_{stab}) des Schaltreglers 3 über eine Reihenschaltung der Emitter-Kollektor-Strecke eines Transistors (T3) und zwei Dioden (D1, D2) erzeugt wird, wobei die Basis des Transistors (T3) an eine Spannungsteilerschaltung parallel zum Ausgang des Schaltreglers angeschlossen ist und der Verbindungspunkt der beiden Dioden (D1, D2) über einen Pumpkondensator (CP) an den ersten Anschluß einer Induktivität des Schaltreglers geführt ist.
5. Elektronische Schaltung Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß
 - im Fall einer richtigen Polung die Gate-Spannung des MOS-Feldeffekttransistors (T1) aus der stabilisierten, Ausgangsspannung (U_{stab}) des Schaltreglers (3) besteht, die auf die Versorgungs-

DE 197 17 527 A 1

5

6

spannung (U_B) aufgesetzt ist.

6. Elektronische Schaltung Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß

- zwischen dem Source- (S) und dem Gate-Anschluß (G) des MOS-Feldeffekttransistors (T1) eine Parallelschaltung aus einem Widerstand (RG) und einem Kondensator (CG) liegt.

7. Elektronische Schaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß

- die elektronische Schaltung (1) zur Ansteuerung von einem oder mehreren Hydraulikventilen vorgesehen ist.

Hierzu 1 Zeichnung

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ZEICHNUNGEN SEITE 1

Nummer:

Int. Cl. 6:

Offenlegungstag:

DE 197 17 527 A1

H01L 23/82

29. Oktober 1998

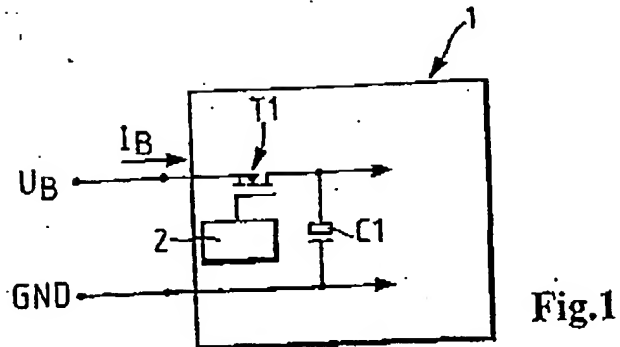


Fig. 1

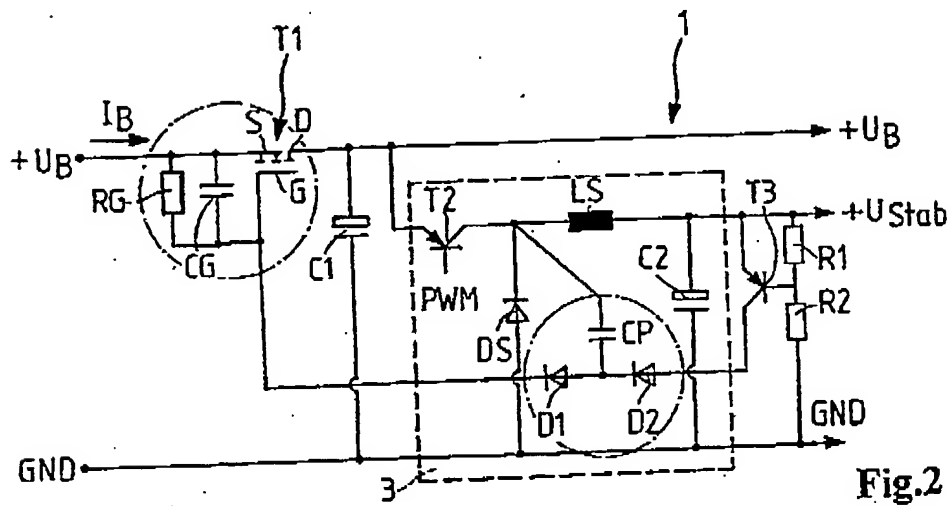


Fig. 2

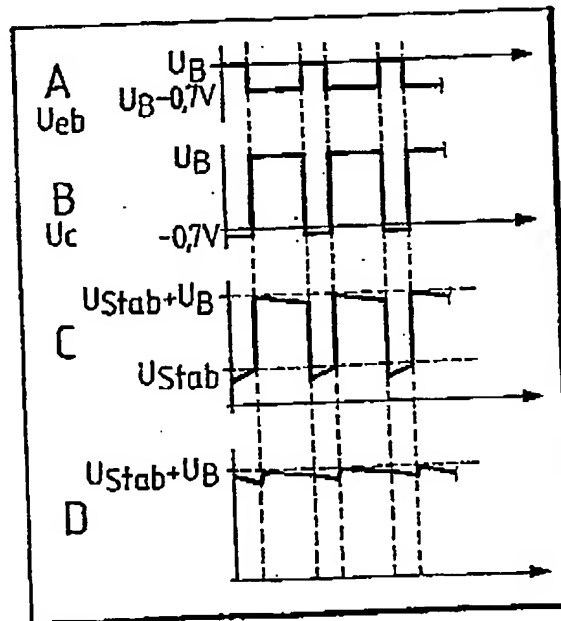


Fig. 3